

फोनान-फोनान पारस्परिक प्रभाव के कारण नायोबियम ऑक्साइड(NbO) में अल्ट्रासोनिक क्षय

अरविन्द कुमार तिवारी
असिस्टेंट प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान विभाग
बी0एस0एन0वी0 पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ-226001, उ0प्र0, भारत
tiwariarvind1@rediffmail.com

प्राप्त तिथि-31.07.2016; स्वीकृत तिथि- 18.09.2016

सार- NbO में <110> दिशा में तापीय परिसर 100-500के0 के बीच फोनान-फोनान पारस्परिक प्रभाव तथा तापीय तन्त्र क्रिया विधि(थर्मोइलास्टिक मैकेनिज्म) के कारण अल्ट्रासोनिक क्षय की गणना की गई है। अल्ट्रासोनिक क्षय तथा अन्य नियतांक(इलास्टिक कॉन्स्टेंट) की भी गणना की गयी है। इस पदार्थ में फोनान-फोनान पारस्परिक प्रभाव से प्राप्य अल्ट्रासोनिक क्षय तापीय तन्त्र हानि के ऊपर अधिक प्रभावी है। NbO के थर्मोइलास्टिक गुणों से सहसम्बद्ध परिणामों की चर्चा की गयी है।

बीज शब्द- तन्त्र नियतांक, अल्ट्रासोनिक वेग, तापीय चालकता, अल्ट्रासोनिक क्षय।

Ultrasonic attenuation in Niobium Oxide(NbO) due to phonon-phonon interaction

Arvind Kumar Tiwari
Assistant Professor, Department of Physics
B.S.N.V. P.G. College, Lucknow-226001, U.P., India
tiwariarvind1@rediffmail.com

Abstract- Ultrasonic attenuation due to phonon-phonon interaction and thermo elastic mechanism have been evaluated in NbO along <110> direction in the temperature range 100-500K. The second and third order elastic constants are also evaluated for the evaluation of ultrasonic attenuation and other associated parameters. The ultrasonic attenuation due to phonon-phonon interaction is predominant over thermo elastic loss in this material. The results are discussed in correlation with thermo elastic properties of NbO.

Key words- Elastic constants, ultrasonic velocity, thermal conductivity, ultrasonic attenuation.

1. **प्रस्तावना-** अल्ट्रासोनिक्स की जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। सन् 1959 से डाईइलेक्ट्रिक्स, ठोस संरचनाओं में अल्ट्रासोनिक तरंगों के मापन में केन्द्र में रहा है। NbO(नायोबियम ऑक्साइड) सफेद क्रिस्टल या पाउडर सा दिखता है। इसका गलनांक 1520⁰सी है। इसका मुख्य अनुप्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में है। अल्ट्रासोनिक क्षय की गणना में द्वितीय तथा तृतीय अनुक्रम के तन्त्र नियतांकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तन्त्र गुण विशिष्ट ताप, डिबॉय ताप, ध्वनि वेग से ऊष्म प्रवैगिकी से जुड़े होते हैं। विभिन्न उच्च तापों पर द्वितीय एवं तृतीय तन्त्र नियतांकों की गणना की गयी है। अल्ट्रासोनिक क्षय की गणना हेतु औसत गुनाइजे प्राचल, तापीय स्थिर समय, असंनदी प्राचल की भी गणना की गयी है। ये गुण पदार्थ के सूक्ष्म संरचनात्मक एवं यांत्रिक गुणों से जुड़े होते हैं।

2. **विधि-** कूलम्ब तथा वार्न-मेयर³ विभव $\phi(r_0)=A \exp(-r_0/b)$ का प्रयोग करते हुए (जहाँ r_0 निकटतम पड़ोस दूरी तथा b वार्न-मेयर विभव है) तथा पारस्परिक प्रभाव द्वितीय निकटतम पड़ोस दूरी तक प्रभावी मानते हुए SOEC तथा TOEC परम शून्य ताप पर प्राप्त किया गया।⁴ परम शून्य ताप के तन्त्र नियतांकों में प्रदोलनात्मक ऊर्जा योगदान को जोड़ते हुए SOEC तथा TOEC अभीष्ट ताप पर प्राप्त किया गया।

$$C_{IJK} = C_{IJK}^0 + C_{IJK}^{Vib.}$$

जहाँ 0 तथा Vib., SOEC तथा TOEC के क्रमशः शून्य ताप तथा प्रदोलनात्मक योगदान को दर्शाता है।⁵⁻⁶

अल्ट्रासोनिक क्षय की गणना निम्न समीकरण से की जाती है।^{1, 7}

$$\left(\frac{\alpha}{f^2}\right)_{\text{Akh.}} = \frac{4\pi^2 \tau E_0 \left(\frac{D}{3}\right)}{2\rho V^3}$$

इसमें V = औसत वेग, E_0 = तापीय ऊर्जा, ρ = घनत्व, τ = तापीय स्थिर समय दर्शाता है।

3. **परिणाम तथा निष्कर्ष**— NbO के द्वितीय एवं तृतीय अनुक्रम के तन्त्र नियतांकों का गणना किया हुआ मान तालिका-1 में दर्शाया गया है।² इन नियतांकों का प्रयोग युनाइजे प्राचलो की गणना में उपयोग होता है। इन मानों का अनुक्रम अन्य NaCl प्रकार के डाईइलेक्ट्रिक पदार्थों जैसा है।

तालिका-1(10^{11} डाइन/सेमी² में)

ताप(केल्विन)→ SOEC/TOEC↓	100K	200K	300K	400K	500K
C ₁₁	7.206	7.338	7.526	7.732	7.838
C ₁₂	5.582	5.494	5.404	5.314	5.269
C ₄₄	5.701	5.716	5.736	5.756	5.567
C ₁₁₁	-90.643	-96.629	-97.185	-97.874	-98.243
C ₁₁₂	-22.696	-22.480	-22.244	-22.008	-21.892
C ₁₂₃	7.961	7.616	7.274	6.933	6.762
C ₁₄₄	8.349	8.394	8.442	8.489	8.514
C ₁₆₆	-23.058	-23.099	-23.159	-23.227	-23.262
C ₄₅₆	8.297	8.297	8.297	8.297	8.297

तालिका-2(10^{-17} Nps²/cm में)

पदार्थ	ताप(K)	$(\alpha/f^2)_{\text{th}}$	$(\alpha/f^2)_{\text{Akh.long}}$	$(\alpha/f^2)^*_{\text{Akh.shear}}$	$(\alpha/f^2)^{\#}_{\text{Akh.shear}}$
NbO	100	0.041	0.030	0.003	0.004
	200	0.078	0.105	0.016	0.015
	300	0.088	0.176	0.039	0.032
	400	0.079	0.217	0.073	0.049
	500	0.062	0.219	0.115	0.059

* < 001 > दिशा में ध्रुवीकृत

< 110 > दिशा में ध्रुवीकृत

फोनान-फोनान पारस्परिक प्रभाव के कारण ताप निर्भर अल्ट्रासोनिक क्षय को तालिका-2 में दर्शाया गया है। इस पदार्थ में तापीय चालकता का मान कम होने की वजह से तापीय तन्त्र हानि(थर्मोइलास्टिक लॉस) फोनान श्यानता हानि(फोनान विस्कॉसिटी लॉस) की तुलना में नगण्य है। तापीय तन्त्र हानि का मान 300के तक ताप बढ़ने पर बढ़ता है इसके पश्चात्

स्थिर होकर घटना प्रारम्भ कर देता है। अल्ट्रासोनिक अवशोषण गुणांक आवृत्ति पर $\left(\frac{\alpha}{f^2}\right)_{\text{Akh.}}$ ताप बढ़ने के साथ बढ़ता

है। उच्च ताप पर इसका मान स्थिर हो जाता है। यह व्यवहार तापीय चालकता के कारण होता है। ऐसा परिवर्तन पूर्व में अध्ययन किये पदार्थों में भी पाया जाता है।⁸ यह स्पष्ट है कि तापीय चालकता अल्ट्रासोनिक क्षय की गणना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अध्ययन को पदार्थों के बनने के दौरान तथा उत्पादन के पश्चात् उनके निरूपण में उपयोग किया जा सकता है।

संदर्भ

1. मेसॉन, डब्ल्यू पी०(1965) फिजिकल एकाउस्टिक्स, एकेडेमिक प्रेस, न्यूयॉर्क 3बी, पृ० 237 ।
2. वाइकॉफ, आर० डब्ल्यू० एफ०(1963) क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इण्टर साइन्स पब्लिशर्स, न्यूयॉर्क, द्वितीय संस्करण ।
3. वार्न, एम० तथा मेयर, जे० ई०(1932) जेड० फिजिक्स, खण्ड-75, पृ० 1 ।
4. ब्रूगर, के०(1964) फिजिक्स रिव्यू ए, खण्ड-133, पृ० 1611 ।
5. मोरी, एस० एवं हिकी वाई०(1978) कैलकुलेशन ऑफ थर्ड एण्ड फोर्थ ऑर्डर इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स इन एल्कली हैलाइड क्रिस्टल्स, ज० फिजिकल सोसा० जापान, खण्ड-45, मु०पृ० 1449-1456 ।
6. ब्रूगर, ए०(1964) थर्मोडायनमिक डेफिनिशन ऑफ हाईयर ऑर्डर इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स, फिजि० रिव्यू, खण्ड-133, पृ० 1611 ।
7. एखीजर, ए०(1939) ऑन द एब्जाव्रेशन ऑफ साउण्ड इन सॉलिड्स, ज० फिजिक्स, यू०एस०एस०आर०, खण्ड-1, मु०पृ० 277 ।
8. सिंह, डी० एवं यादव, आर० आर०(2003) थर्मल कन्डक्टिविटी एण्ड अल्ट्रासोनिक एट्यूनिशन इन डाईइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, ज० प्योर एप्लाइड अल्ट्रासोनिक्स(जे०पी०ए०यू०), खण्ड-25, पृ० 82 ।